**Список публикаций Ключникова Алексея Сергеевича**

1. В.Д. Евдокимов, А.Г. Балашов, А.С. Ключников Исследование эмиттерно-базового узла SiGe ГБТ с целью повышения динамических характеристик прибора методами приборно-технологического моделирования// XXXIX Гагаринские чтения. Научные труды Международной молодёжной научной конференции в 9 томах. – М.: МАТИ, 2013. – Т. 3. – С. 17–18.
2. В.Д. Евдокимов, А.Г. Балашов, А.С. Ключников Оптимизация эмиттерного узла SiGe гетеропереходного биполярного транзистора с целью повышения частотных характеристик методами приборно-технологического моделирования// 20-я Всероссийская межвузовская научно- техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2013» – М.: МИЭТ, 2013. – С. 89.
3. А.Г. Балашов, А.С. Ключников, В.Д. Евдокимов Подходы к масштабированию N-P-N SiGe ГБТ// XL Гагаринские чтения. - Международная молодежная научная конференция. – 2014. – Т. 3. – С. 24–26.
4. Е.А. Артамонова, А.С. Ключников, А.Ю. Красюков, Т.Ю. Крупкина, Н.А. Шелепин Настройка численной модели для исследования транзисторных МОП-структур КНИ-типа с проектными нормами 180 нм в среде TCAD// Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем-2014 (МЭС-2014). С. 151-154.
5. А.С. Бенедиктов, П.В. Игнатов, А.С. Ключников, А.Н. Смирнов, Т.Ю. Егорова Исследование работы МОП-транзисторов на структурах кремний на изоляторе при высоких температурах// Нано- и микросистемная техника. – 2015. № 6. с. 53- 56.
6. Ю.А. Чаплыгин, А.Г. Балашов, В.Д. Евдокимов, А.С. Ключников, Исследование быстродействия SiGe ГБТ при переходе к суб-100 нм топологическим размерам// Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем-2016 (МЭС-2016). С. 32-36.
7. К.А. Панышев, А.С. Ключников Эффект радиационно-индуцированной защелки в 90 нм КМОП-технологии в зависимости от угла и места падениятяжелой заряженной частицы// Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2016. – №. 3. – С. 4-9.
8. Г.В. Баранов, А.С. Ключников Физические особенности использования POLYSI затвора в Tri-gate транзисторе//   
   Тезисы докладов 2-ой научной конференции форума «Микроэлектроника-2016» . 2016. С. 186-187.
9. С.Н. Орлов, Е.С. Горнев, А.С. Ключников, В.П. Тимошенков, О.А. Греков Матрица транзисторов для 3D – элементов микросистемной техники, формируемых внутри канавок в кремниевой пластине Тезисы докладов 2-ой научной конференции форума «Микроэлектроника-2016» .2016.С. 469-474.
10. В.А. Нагнойный, А.Ю. Красюков, Г.В. Баранов, А.С. Ключников Влияние размерного фактора на проявление короткоканальных эффектов в Tri-gate транзисторе// Тезисы докладов конференции «Кремний 2016». – 2016. С. 103

Ученый секретарь

диссертационного совета Д212.131.02

кандидат физико-математических наук Л.Ю. Фетисов